

# 方形氮化镓衬底厂家 10\*10.5mm氮化镓自支撑晶片厂商

产品名称	方形氮化镓衬底厂家 10*10.5mm氮化镓自支撑晶片厂商
公司名称	苏州恒迈瑞材料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:恒迈瑞 型号:10*10.5mm <sup>2</sup> 产地:苏州
公司地址	苏州市吴中区苏蠡路60号(蠡盛大厦)507室(注册地址)
联系电话	15366208370

## 产品详情

### 方形氮化镓衬底厂家 10\*10.5mm氮化镓自支撑晶片厂商

苏州恒迈瑞材料科技生产供应10mm\*10.5mm方形氮化镓自支撑衬底片，衬底厚度350um ± 25um，掺杂类型分为N型非掺杂，硅掺杂及半绝缘型Fe铁掺杂。GaN氮化镓自支撑衬底晶片TTV 10um，抛光类型可选单面抛光SSP或双面抛光DSP。

第三代半导体材料包括了以碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)为代表的宽禁带化合物半导体。第一二代半导体材料工艺已经逐渐接近物理极限，在微电子领域的摩尔定律开始逐步失效，而第三代半导体是可以超越摩尔定律的。相比于第一代及第二代半导体材料，第三代半导体材料在高温、高耐压以及承受大电流等多个方面具备明显的优势，因而更适合于制作高温、高频、抗辐射及大功率器件。在器件的性能对比上，GaN材料以及SiC材料在通态电阻以及击穿电压方面都具备较大的优势。